

2025 年 6 月 23 日

各 位

J X 金属株式会社

次世代半導体の高性能化に不可欠な高純度 CVD・ALD 材料の供給体制を強化 —急速な成長を遂げる生成 AI のさらなる進化に貢献—

J X 金属株式会社（社長：林 陽一、以下「当社」）は、次世代半導体向け CVD・ALD 材料における足元の急速な需要立ち上がりに対応すべく供給体制の強化を進めてまいりましたが^(※1)、この度、当社の投資により進めていた東邦チタニウム茅ヶ崎工場敷地内の生産設備増強が完了し、フル操業を開始しましたのでお知らせいたします。さらに、当社茨城事業所（日立地区）においても生産設備導入を進めており、今後見込まれる一層の需要増大に対応してまいります。

生成 AI の進化を支える各種ロジック半導体、3D-NAND フラッシュメモリや HBM に代表されるメモリ半導体は、配線の微細化や多層化により高性能化が図られており、そのような微細かつ複雑構造への配線形成に欠かせない CVD・ALD 材料へのニーズが拡大しています。一方で、次世代半導体の微細化進展に伴い、配線抵抗の増加、ノイズの増大といった課題が生じており、それらの解決策として配線構造の変更に加え、新しい材料採用の動きも高まっています。当社が製造を開始した CVD・ALD 材料のひとつであるモリブデン化合物は、それら課題の解決手段となるだけでなく、当社保有の高純度化技術により不純物を低減しているため、歩留まり向上への貢献も期待できる材料です。

また、上述した国内拠点だけでなく、2024 年 11 月には、当社グループ会社でドイツに拠点を有する TANIOBIS 社において、多様な CVD・ALD 材料の開発・生産が可能な設備を稼働しており^(※2)、グローバルな供給体制を強化し、安定供給と事業継続性を確保する体制を整えました。引き続き、当社がスパッタリングターゲットビジネス等で築いた半導体分野の幅広い知見やネットワークを活用して、グループ全体で CVD・ALD 材料事業の拡大に繋げてまいります。

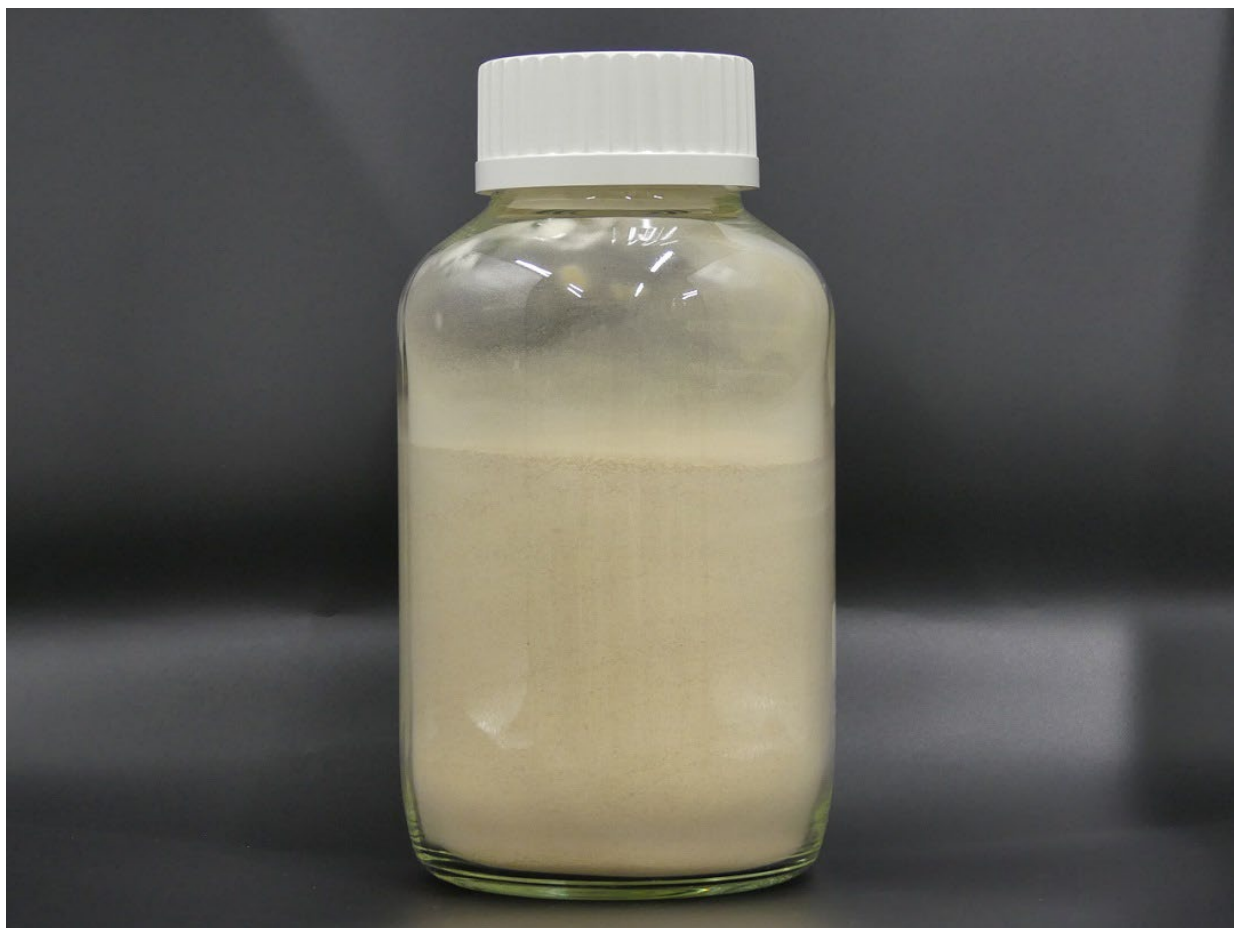
「2040 年 J X 金属グループ長期ビジョン」で掲げる「技術立脚型企業」への転身に向けた施策を推進し、先端素材で社会の発展と革新に貢献するグローバル企業を目指してまいります。

以 上

【参考】

(※1) 2024 年 6 月 18 日付プレスリリース「[次世代半導体向け CVD・ALD 材料の本格生産に向けた能力増強の決定について](#)」

(※2) 2024 年 11 月 13 日付プレスリリース「[TANIOBIS 社ドイツ拠点における高純度金属化合物の開発・生産設備の稼働開始について —半導体向け CVD・ALD プリカーサ材料の製品ポートフォリオ拡充を推進—](#)」



モリブデン化合物の写真